

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 1月28日(木) 10:00~15:50

会場 機械振興会館6階66号会議室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. [http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map\\_kaikan.htm](http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm) TEL [03] 3434-8211)

議題 先端CMOSデバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

1. [招待講演] Experimental Study on Carrier Transport Properties in Extremely-Thin Body Ge-on-Insulator (GOI) p-MOSFETs with GOI Thickness Down to 2 nm ○X. Yu・Shinichi Takagi (Univ. of Tokyo)
2. [招待講演] Advanced SPC プロセスにより形成された高移動度 poly-Si ナノワイヤトランジスタにおける電気輸送特性 ○小田 穰・佐久間 究・上牟田雄一・齋藤真澄 (東芝)
3. [招待講演] Understanding of BTI for Tunnel FETs 水林 亘 (産総研)
4. [招待講演] Van der Waals Junctions of Layered 2D Materials for Functional Devices 町田友樹 (東大)
5. [招待講演] CMOS Photonics Technologies Based on Heterogeneous Integration of SiGe/Ge and III-V on Si 竹中 充 (東大)
6. [招待講演] 2RW Dual-port SRAM Design Challenges in Advanced Technology Nodes 新居浩二 (ルネサス)
7. [招待講演] 次世代垂直磁化 MTJ を用いた高速・低消費電力のキャッシュメモリ階層技術を持つノーマリーオフプロセッサ 池上一隆 (東芝)
8. [招待講演] 極低ドレイン電圧で急峻な S 値を持つ PN Body Tied SOI FET 井田次郎 (金沢工大)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

3月3日(木), 4日(金) 北大百年記念会館 [未定] テーマ: 機能ナノデバイス及び関連技術

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp